

Грачев, ген. директор НПФ «Гранч», г. Новосибирск.

**16.30 – 16.45 Перерыв на кофе.**

**16.45 – 17.30** Обзорный доклад «Основные Особенности Развития Современной Полупроводниковой Промышленности». Докладчик – к.т.н. А.В. Глухов, нач. ОКБ при НЗПП, г. Новосибирск.

**17.30 – 18.15** Обзорный доклад «Формирование металл - интерметаллидных многослойных композитов с использованием метода сварки взрывом». Докладчик – д.т.н., проф. В.А. Батаев, НГТУ, г. Новосибирск.

**19.00 – 20.00 Ужин**

**20.00 – 22.00 Культурная программа**

## 28 июня

**9.00 – 10.40 Завтрак**

### Секция 1. Нанотехнологии. Заседание 1.

Зал А.

**10.00 – 10.20** Доклад «Effect of ZnO films upon the GaAs epitaxial growth». Докладчик – к.т.н., доц. М.С. Солодовник, ЮФУ, г. Таганрог.

**10.20 – 10.40** Доклад «Surface Diffusion of Ga Adatoms on MBE-grown GaAs(001) Surface Studied by Monte Carlo Simulations». Докладчик – С.В. Балакирев, ЮФУ, г. Таганрог.

**10.40 – 11.00** Доклад «Исследование Электрофизических и Оптических Свойств Нанокристаллических Пленок  $\text{In}_2\text{O}_3\text{-Ga}_2\text{O}_3$ , Полученных Импульсным Лазерным Напылением». Докладчик – И.Е. Дёмин, Омский университет дизайна и технологий, г. Омск.

**11.00 – 11.20** Доклад «Зарождение Двумерных Островков при Высокотемпературном Эпитаксиальном Росте на Поверхности Si(111)». Докладчик – Б.И. Дейнекин, НГТУ, г. Новосибирск.

**11.20 – 11.40** Доклад «Perovskite – New Material for Thin-Film Solar Cells». Докладчик – Е.С. Юданова, ИФП СО РАН им. А.В. Ржанова, г. Новосибирск.

**11.40 – 11.55 Перерыв на кофе.**

### Секция 1. Нанотехнологии. Заседание 2.

Зал А.

**11.55 – 12.35** Доклад «От субмикронных квантовых проводников к графеноподобной решетке: эксперименты и моделирование». Докладчик –

В.А. Ткаченко, ИФП СО РАН им. А.В. Ржанова, г. Новосибирск.

**12.35 – 12.55** Доклад «Исследование Двумерных Массивов Нанокристаллов CdSe Методом Высокорастворимой Электронной Микроскопии». Докладчик – А.К. Гутаковский, ИФП СО РАН им. А.В. Ржанова, г. Новосибирск.

**12.55 – 13.15** Доклад «Влияние Межзеренных Границ на Проводимость в Канале Поликремниевых Тонкопленочных Транзисторов». Докладчик – В.И. Сабурова, ИФП СО РАН им. А.В. Ржанова, г. Новосибирск.

**13.30 – 14.30 Обед**

### Секция 2. Наноматериалы. Заседание 1.

Зал Б.

**10.00 – 10.20** Доклад «Формирование композиционного материала на основе сплавов титана и железа». Докладчик – К.А. Скороход, НГТУ, г. Новосибирск.

**10.20 – 10.40** Доклад «Химический состав и структура наноразмерных волокон оксида вольфрама». Докладчик – Р.С. Воробьев, НГТУ, г. Новосибирск.

**10.40 – 11.00** Доклад «Структура и свойства композиционных покрытий В4С-Ni, полученных воздушно-плазменным напылением». Докладчик – В. Безрукова, НГТУ, г. Новосибирск.

**11.00 – 11.20** Доклад «Влияние наноразмерных частиц меди на механические и антифрикционные свойства стали». Докладчик – А.А. Разумаков, НГТУ, г. Новосибирск.

**11.20 – 11.40** Доклад «Создание керамического материала с субмикроструктурной структурой». Докладчик – А.В. Фелюфьянова, НГТУ, г. Новосибирск.

**11.40 – 11.55 Перерыв на кофе.**

### Секция 2. Наноматериалы. Заседание 2.

Зал Б.

**11.55 – 12.15** Доклад «Исследование интерметаллида  $\text{Ni}_3\text{Al}$ , полученного методом искрового плазменного спекания нанопорошков Ni и Al». Докладчик – С.Н. Гуленкова, НГТУ, г. Новосибирск.

**12.15 – 12.35** Доклад «Исследование порошкового сплава на основе алюминиды никеля, полученного SPS методом». Докладчик – Л.И. Шевцова, НГТУ, г. Новосибирск.

**12.35 – 12.55** Доклад «Аморфные и квазикристаллические структуры, формируемые при свар-